

СОДЕРЖАНИЕ

Том 39, номер 1, 2010

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ МИКРО- И НАНОЭЛЕКТРОНИКИ

Влияние шероховатой поверхности кремниевой пластины на ее температуру при нагреве некогерентным излучением

В. И. Рудаков, В. В. Овчаров, В. П. Пригара

3

Новая технология изготовления диэлектрической изоляции элементов приборов микроэлектроники с использованием окисления канавок в монокремнии

Ю. П. Снитовский, М. Г. Красиков

14

Диагностический контроль надежности интегральных схем с использованием шумов и воздействия электростатических разрядов

М. И. Горлов, Д. Ю. Смирнов, Р. М. Тихонов

21

ТОНКИЕ ПЛЕНКИ

Низкотемпературное импульсное газофазное осаждение тонких слоев металлического рутения для микро- и нанoeлектроники. Часть I. Оборудование и методология импульсного осаждения

В. Ю. Васильев

28

ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ПРИБОРЫ

Определение диффузионной длины неосновных носителей заряда с использованием цифрового осциллографирования сигнала поверхностной фотоЭДС

В. Н. Подшивалов

38

Начальная разность потенциалов интегрального магнитотранзисторного датчика

Р. Д. Тихонов

46

СХЕМОТЕХНИКА

Низковольтные арифметические устройства на полностью обедненных КМОП КНИ нанотранзисторах

Н. В. Масальский

59

МОДЕЛИРОВАНИЕ

Межподзонные оптические переходы в квантовых ямах типа InAs/GaSb

И. А. Семенихин, А. А. Захарова, К. А. Chao

68

Авторский указатель тома 38, 2009

78